

Photodiode JE4,8



- Charakteristik :
- ◆ Spektralbereich 400 ... 1100 nm
 - ◆ strahlungsempfindliche Fläche (2,2 x 2,2) 4,8 mm²
 - ◆ hochwertige Si - PIN - Photodiode mit erhöhter IR - Empfindlichkeit, niedrigem Dunkelstromniveau, hohem Nullpunktwidestand und hoher spektraler Empfindlichkeit
 - ◆ hermetisches TO39 - Gehäuse

- Applikationen :
- ◆ universeller Detektor für lichttechnische und nichtoptische Anwendungen (α , β , γ - Detektion)

Grenzwerte:

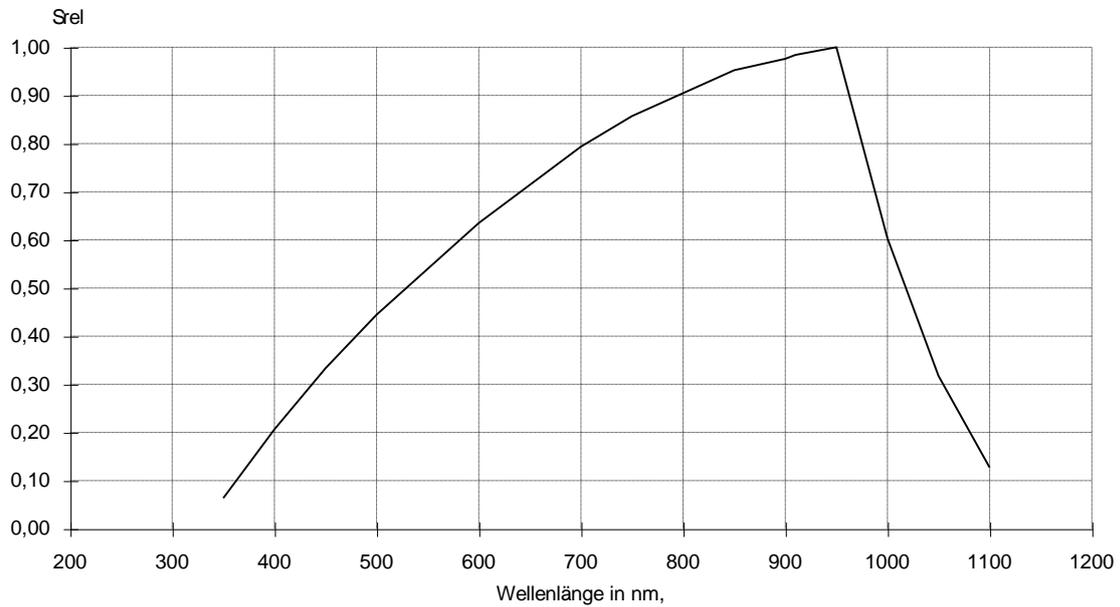
Sperrspannung	20	V
Betriebstemperaturbereich	- 25 °C ... 80	°C
Lagertemperaturbereich	- 40 °C ... 100	°C
Löttemperatur (3s)	260	°C

Technische Daten :

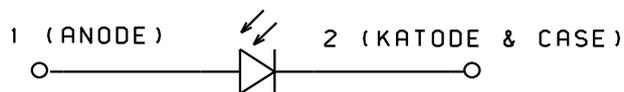
Allgemeine Meßbedingungen, sofern nicht anders spezifiziert: $\gamma_a = 23$ °C, $V_R = 0V$

Parameter	Meßbedingung	min.	typ.	max.	Einh.
strahlungsempfindliche Fläche A			4,8		mm ²
Max. der spektralen Empfindlichkeit S_{max} bei			950		nm
Spektralbereich λ_{min} λ_{max}	$S = 0,1 \cdot S_{max}$		400 1100		nm
absolute spektrale Empfindlichkeit	$\lambda = 900$ nm	0,55	0,65		A/W
Dunkelstrom I_R	$V_R = 10V$ $E = 0$ lx		2	20	nA
Anstiegszeit Abfallzeit des Fotostromes	$R_L = 1k\Omega$ $\lambda = 830$ nm $V_R = 5V$ $I_P = 20$ μA		150		ns
Kapazität	$f = 1$ MHz $E = 0$ lx, $V_R = 0V$ $E = 0$ lx, $V_R = 20V$		50 8		pF pF

Relative spektrale Empfindlichkeit



Innenschaltung



Gehäuseabmessungen

